

晶体振荡器 (SPXO)
输出:CMOS

SG-211S*E

- 频率范围 : 2.375 MHz ~ 60 MHz
- 电源电压 : 1.8 V Typ. / 2.5 V Typ. / 3.3 V Typ.
- 电流消耗 : 1.2 mA Typ.
(SEE 1.8 V 无负载条件 40 MHz)
- 功能 : 待机 (ST)
- 外部尺寸规格 : 2.5 × 2.0 × 0.7 mm



产品号码(请联系我们)
X1G0036x1xxxx00



实际尺寸



规格 (特征)

项目	符号	规格说明			条件
		SG-211SEE	SG-211SDE	SG-211SCE	
输出频率范围	f _o	2.375 MHz ~ 60.000 MHz			请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压	V _{cc}	1.8 V Typ. 1.6 V ~ 2.2 V	2.5 V Typ. 2.2 V ~ 2.7 V	3.3 V Typ. 2.7 V ~ 3.63 V	
储存温度	T _{stg}	-40 °C ~ +125 °C			裸存
工作温度	T _{use}	-40 °C ~ +90 °C			
频率稳定度	f _{tol}	D : ±20 × 10 ⁻⁶ , E : ±15 × 10 ⁻⁶			-20 °C ~ +70 °C
		H : ±20 × 10 ⁻⁶ , T : ±15 × 10 ⁻⁶			-40 °C ~ +85 °C
		a : ±15 × 10 ⁻⁶ , b : ±20 × 10 ⁻⁶ , d : ±25 × 10 ⁻⁶			-40 °C ~ +90 °C
功耗	I _{cc}	2.3 mA Max.	2.5 mA Max.	3.5 mA Max.	无负载条件, 2.375 MHz ≤ f _o ≤ 32 MHz
		2.8 mA Max.	3.0 mA Max.	4.0 mA Max.	无负载条件, 32 MHz < f _o ≤ 40 MHz
		3.3 mA Max.	3.5 mA Max.	4.5 mA Max.	无负载条件, 40 MHz < f _o ≤ 48 MHz
		4.5 mA Max.	5.0 mA Max.	6.0 mA Max.	无负载条件, 48 MHz < f _o ≤ 60 MHz
待机电流	I _{std}	5.0 μA Max.			ST = GND
占空比	SYM	45 % ~ 55 %			50 % V _{cc} 级别, L _{CMOS} ≤ 15 pF
输出电压	V _{OH}	90 % V _{cc} Min.			I _{OH} = -4 mA
	V _{OL}	10 % V _{cc} Max.			I _{OL} = 4 mA
输出负载条件 (CMOS)	L _{CMOS}	15 pF Max.			
输入电压	V _{IH}	80 % V _{cc} Min.			ST 终端
	V _{IL}	20 % V _{cc} Max.			
上升/下降时间	t _r / t _f	4.5 ns Max.			20 % V _{cc} ~ 80 % V _{cc} 极 L _{CMOS} = 15 pF
振荡启动时间	t _{str}	5 ms Max.			在 90 % V _{cc} 时, 所需时间为 0 秒
频率老化	f _{aging}	频率稳定度包含			+25 °C, 第一年, V _{cc} = 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V

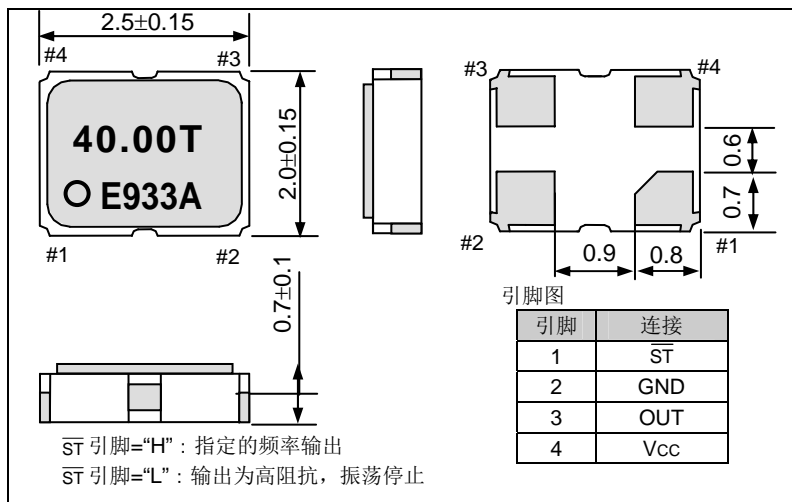
产品名称 SG-211 S E E 40.000000MHz D
(标准显示) ① ②③ ④ ⑤
①型号 ②功能(S:待机) ③电源电压
④频率 ⑤频率稳定度

③电源电压	
E	1.8 V Typ.
D	2.5 V Typ.
C	3.3 V Typ.

⑤频率稳定度	
D	±20 × 10 ⁻⁶ / -20 ~ +70 °C
E	±15 × 10 ⁻⁶ / -20 ~ +70 °C
H	±20 × 10 ⁻⁶ / -40 ~ +85 °C
T	±15 × 10 ⁻⁶ / -40 ~ +85 °C
a	±15 × 10 ⁻⁶ / -40 ~ +90 °C
b	±20 × 10 ⁻⁶ / -40 ~ +90 °C
d	±25 × 10 ⁻⁶ / -40 ~ +90 °C

外部尺寸规格

(单位: mm)



推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

